

محاسبه عددی ضریب خودالقائی معادل سیمپیچ در فرآیند انبساط

الکترومغناطیسی استوانه

محمد صدیقی، مهرداد خاندانی و محمدعلی لیاقت

دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران

پست الکترونیکی: sedighi@iust.ac.ir

چکیده

ضریب خودالقائی، یکی از پارامترهای مهمی است که در فرآیند شکل دهی الکترومغناطیسی با آن روبرو هستیم. قرار گرفتن قطعه کار در مجاورت سیمپیچ، اثر قابل ملاحظه ای در ضریب خودالقائی سیمپیچ ایجاد می کند و لذا پارامترهای مختلف فرآیند از قبیل دامنه، و فرکانس جریان الکتریکی، میدان مغناطیسی و فشار وارد بر قطعه کار را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. این مقاله، با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود ANSYS به محاسبه عددی و بررسی ضریب خودالقائی معادل سیمپیچ و قطعه کار در فرآیند انبساط الکترومغناطیسی استوانه، که تا کنون در مقالات و مراجع مربوط به فرآیند شکل دهی الکترومغناطیسی مورد محاسبه قرار نگرفته است، می پردازد. ابتدا برای تعیین چگونگی توزیع جریان الکتریکی بر روی مقطع حلقه های سیمپیچ، یک سیمپیچ استوانه ای بدون قطعه کار شبیه سازی می شود. با استفاده از نتایج شبیه سازی، نمودار تغییرات شار مغناطیسی گذرنده از سیمپیچ در برابر تغییرات جریان الکتریکی به دست می آید و ضریب خودالقائی که عبارت است از شبیب نمودار مذکور، توسط روش حداقل سازی مربعات محاسبه می شود. ضرایب خودالقائی سیمپیچ هایی با ابعاد مختلف که به همین ترتیب شبیه سازی و محاسبه شده اند، انطباق خوبی را با نتایج محاسبات تحلیلی موجود در مراجع نشان می دهند. لذا از همین روش برای شبیه سازی و محاسبه ضریب خودالقائی معادل سیمپیچ و قطعه کار در فرآیند انبساط استوانه استفاده می گردد. سپس شبیه سازی و محاسبات مذکور برای قطعه کارهایی با قطرهای مختلف تکرار می شود. نتایج حاصله نشان می دهند که روند تغییرات ضریب خودالقائی به ازاء قطرهای مختلف قطعه کار، با نتایج تجربی که قبلاً در مورد تأثیر وجود یک محفظه رسانای خارجی در اطراف سیمپیچ در مراجع ارائه شده اند تطابق دارد.

واژه های کلیدی: شکل دهی الکترومغناطیسی، انبساط استوانه، ضریب خودالقائی

مقدمه

شكل دهی ورق های فلزی به دلیل کاربرد وسیع در صنایع مختلف، یکی از مهم ترین فرآیندهای ساخت محسوب می گردد. این در حالیست که انجام این دسته فرآیندها، همواره با مشکلاتی از قبیل بازگشت فری زیاد، چین خوردگی و قابلیت شکل پذیری پائین ورق که منجر به پارگی آن می شود رو برو است.

نتایج شبیه سازی ها و آزمایشات تجربی نشان می دهد که در فرآیندهای شکل دهی با نرخ کرنش بالا، مشکلات مذکور تا حدود زیادی مرتفع می شوند. دلیل اصلی این مسئله، تأثیر قابل ملاحظه نرخ کرنش، در خواص مواد است. هنگامی که تغییر فرم با نرخ کرنش بسیار بالا صورت می گیرد، قابلیت شکل پذیری فلز تا حد قابل ملاحظه ای افزایش یافته، بازگشت الاستیک آن کمتر شده و احتمال وقوع چین خوردگی نیز در آن کاهش می باید. یکی از فرآیندهای شکل دهی ورق با نرخ کرنش بالا که برای فلزاتی با قابلیت هدایت الکتریکی بالا مانند آلیاژ های آلمینیوم بسیار مناسب است، فرآیند شکل دهی الکترو مغناطیسی می باشد. در فرآیند شکل دهی الکترو مغناطیسی، نیروی لازم جهت تغییر فرم ورق توسط یک پالس مغناطیسی قوی و بسیار سریع تأمین می گردد. بدین ترتیب که ابتدا یک بانک خازن با ولتاژ مناسبی شارژ می شود. سپس این بانک خازن وارد مداری شامل یک سیم پیچ که متناسب با شکل قطعه کار طراحی شده و در مجاورت آن قرار گرفته است می شود. با بسته شدن کلید مدار، یک پالس قدرتمند و سریع جریان در سیم پیچ جاری شده و سبب شکل گرفتن یک پالس مغناطیسی در مجاورت قطعه کار می گردد. در سال های اخیر تلاش هایی برای شبیه سازی این فرآیند صورت گرفته است. شبیه سازی و تحلیل الکترو مغناطیسی قطعات فلزی به

لیست علائم و نشانه ها

- R_0 : مقاومت اهمی معادل اجزاء دستگاه
- R_1 : مقاومت اهمی معادل سیم پیچ
- R_2 : مقاومت اهمی معادل قطعه کار
- R : مقاومت اهمی معادل کل
- L_0 : ضریب خود القائی مدار دستگاه
- L_1 : ضریب خود القائی سیم پیچ
- L_2 : ضریب خود القائی معادل قطعه کار
- L : ضریب خود القائی معادل کل
- M : ضریب القاء متقابل بین سیم پیچ و قطعه کار
- L_C : طول سیم پیچ
- C : ظرفیت بانک خازن
- V_C : ولتاژ شارژ بانک خازن
- I_C : جریان گذرنده از سیم پیچ
- I_W : جریان گردابی در قطعه کار
- I_{eq} : جریان معادل یکنواخت سیم پیچ
- N : تعداد حلقه های سیم پیچ
- ω_d : سامد زاویه ای
- r : مختصه شعاعی
- φ : مختصه دورانی
- $I_{0,1}$: توابع بسل نوع اول
- $K_{0,1}$: توابع بسل نوع دوم
- μ : ضریب نفوذ پذیری مغناطیسی
- μ_0 : ضریب نفوذ پذیری مغناطیسی هوا
- μ_r : ضریب نفوذ پذیری مغناطیسی نسبی
- σ : رسانندگی الکتریکی ویژه
- ρ_e : مقاومت الکتریکی ویژه
- ϕ : شار مغناطیسی سیم پیچ
- t : زمان
- A : سطح مقطع داخلی سیم پیچ

شبیه‌سازی، وابستگی متقابل بین میدان الکترومغناطیس و تغییر فرم قطعه در نظر گرفت نشد. آنگر^۷ [۷] در سال ۲۰۰۶ یک فرمول‌بندی سه‌بعدی عمومی با در نظر گرفتن میدان‌های الکترومغناطیس، دما و تغییر فرم برای شبیه‌سازی مسائل شکل‌دهی الکترومغناطیسی ارائه نمود. وانگ^۸ [۸] نیز در سال ۲۰۰۶ از نرم‌افزار اجزاء محدود ADINA برای شبیه‌سازی شباهستاتیکی شکل‌دهی یک ورق تخت استفاده نمود.

در تمام شبیه‌سازی‌های اشاره شده، جریان الکتریکی گذرنده از سیم پیچ به صورت تجربی اندازه‌گیری شده و در فرآیند شبیه‌سازی، به عنوان بار خارجی، مورد استفاده قرار گرفته است. دلیل این امر، پیچیدگی‌هایی است که در محاسبه جریان الکتریکی گذرنده از سیم پیچ، در فرآیند شکل‌دهی الکترومغناطیسی، وجود دارد. برخی از این پیچیدگی‌ها عبارتند از: القاء متقابل بین سیم پیچ و مدار دستگاه، خودالقائی معادل مدار دستگاه، لزوم تعیین مقاومت اهمی معادل در مدار دستگاه و سیم پیچ، تأثیر قطعه کار در ضریب خودالقائی معادل سیم پیچ و ... در صورتی که برای تمام این موارد فرض‌ها و اطلاعات کافی داشته باشیم، می‌توانیم بدون نیاز به اندازه‌گیری تجربی، با دقت قابل قبول، جریان گذرنده از سیم پیچ را محاسبه نموده و در شبیه‌سازی به کار ببریم.

در این مقاله از بین موارد فوق، به بررسی تأثیر قطعه کار در ضریب خودالقائی سیم پیچ در فرآیند انبساط الکترومغناطیسی استوانه، که دارای کاربردهای فراوان صنعتی می‌باشد، می‌پردازیم. در کاربردهای صنعتی فرآیند شکل‌دهی الکترومغناطیسی، اندازه‌گیری و تعیین یک ضریب خودالقائی معادل برای مجموعه سیم پیچ و قطعه کار، بسیار مفید خواهد بود [۶]. زیرا از این ضریب

روش‌های مختلفی قابل انجام است، اما در شبیه‌سازی فرآیند شکل‌دهی الکترومغناطیسی به دلیل همزمانی پدیده تغییر فرم مکانیکی قطعه کار با تغییرات میدان مغناطیسی، محدودیت‌ها و پیچیدگی‌هایی در روش شبیه‌سازی وجود دارد. در سال‌های اخیر، از روش اجزاء محدود در تحلیل جنبه‌های مختلف فرآیند شکل‌دهی الکترومغناطیسی استفاده شده است. در اینجا به برخی از مهم‌ترین مقالاتی که در حوزه شبیه‌سازی اجزاء محدود این فرآیند ارائه شده است اشاره می‌کنیم. موراکشی^۱ [۱] در سال ۱۹۹۸ از یک روش استاتیکی برای انتقاض موضعی یک سیلندر استفاده کرد. در این شبیه‌سازی فشار مغناطیسی با یک روش تقریبی به صورت مقداری ثابت در نظر گرفته شد. فنتون^۲ [۲] در سال ۱۹۹۸، از یک کد دو بعدی تفاضل محدود برای شبیه‌سازی تغییر فرم آزاد یک دیسک دایره‌ای استفاده نمود. چانفونگ^۳ [۳] در سال ۲۰۰۲، با روش اجزاء محدود توزیع فشار مغناطیسی را روی قطعه کار، در یک فرآیند انبساط سیلندر به دست آورد. این تحلیل به صورت دو بعدی انجام شد و از تغییر فرم ورق نیز صرف نظر شد. ال-ازاب^۴ [۴] در سال ۲۰۰۳ یک فرمول‌بندی عمومی را برای مدل‌سازی فرآیند شکل‌دهی الکترومغناطیسی ارائه نمود و از آن برای تحلیل اجزاء محدود مسئله الکترومغناطیسی شکل‌دهی یک ورق تخت استفاده نمود. ماما لیس^۵ [۵] در سال ۲۰۰۵، مسئله انتقاض آزاد سیلندر را با روش اجزاء محدود شبیه‌سازی کرد. الیوریا^۶ [۶] نیز در سال ۲۰۰۵، یک مسئله تغییر فرم ورق تخت را با استفاده از دو نرم‌افزار مجزا برای حل مسائل الکترومغناطیس و تغییر فرم شبیه‌سازی نمود. در این

1- Murakoshi

2- Fenton

3- Chunfeng

4- El-Azab

5- Mamalis

6- Oliveira

در فرآیند انبساط الکترومغناطیسی استوانه محاسبه می‌گردد. سپس تأثیر اندازه قطر داخلی قطعه کار را بر این ضریب خودالقائی معادل بررسی می‌نماییم. به این منظور ضریب خودالقائی معادل مجموعه سیم پیچ و قطعه کار را برای قطعه کارهایی با قطرهای داخلی مختلف محاسبه کرده و نتایج را با هم مقایسه می‌کنیم.

در این مقاله، تحلیل اجزاء محدود توسط نرمافزار ANSYS انجام شده است. این نرمافزار یک کد تجاری اجزاء محدود با قابلیت تحلیل دو بعدی و سه بعدی است که تحلیل‌های مختلف سازه‌ای، سیالاتی، حرارتی، الکتریکی و مغناطیسی را در حالت‌های استاتیکی و دینامیکی و همچنین خطی و غیر خطی انجام می‌دهد. این نرمافزار قابلیت انجام تحلیل‌های جفت‌شدگی حاصل از واپستگی متقابل بین دو یا سه مورد از زمینه‌های مذکور را نیز دارد. ویژگی‌هایی مانند وسعت زمینه‌های کاربردی، محیط مدل‌سازی قدرتمند (نسبت به سایر نرمافزارهای اجزاء محدود)، قابلیت تحلیل دینامیکی صریح^۱ و ضمنی^۲، قابلیت شبکه‌بندی^۳ بالا و همچنین قابلیت‌ها و امکانات جانبی مربوط به تحلیل اجزاء محدود مانند روش‌ها و حلگرهای عددی متنوع سبب استفاده گسترده از این نرم‌افزار در زمینه‌های گوناگون شده است. مرور مقالات تحقیقاتی نشان می‌دهد که این نرمافزار در بسیاری از پژوهه‌های تحقیقاتی مورد استفاده قرار گرفته و نتایج بسیار خوبی را در برداشته است. نرمافزار مذکور در زمینه شبیه‌سازی اجزاء محدود جنبه‌های مختلف فرآیند شکل‌دهی الکترومغناطیسی نیز توسط محققین به کار گرفته شده است.

خودالقائی معادل می‌توان در تعیین پارامترهای مربوط به دستگاه، مانند ظرفیت بانک خازن و ولتاژ شارژ آن بهره بردار. این در حالیست که تاکنون در هیچ یک از مقالات مربوط به شبیه‌سازی و تحلیل فرآیند شکل‌دهی الکترومغناطیسی، ضریب خودالقائی معادل سیم پیچ و قطعه کار مورد محاسبه قرار نگرفته است. در مقاله حاضر با استفاده از روش اجزاء محدود به محاسبه این ضریب می‌پردازیم. ابتدا به منظور تعیین چگونگی توزیع جریان الکتریکی بر روی مقطع حلقه‌های سیم پیچ و اعتبارسنجی نتایج شبیه‌سازی، ضریب خودالقائی یک سیم پیچ استوانه‌ای خالی را محاسبه نموده و با نتایج تحلیلی مربوط به مرجع [۹] مقایسه می‌کنیم. در شبیه‌سازی‌های سیم پیچ و قطعه کار استوانه‌ای، با توجه به تقارن‌های موجود، تنها یک هشتمن از مدل واقعی شبیه‌سازی می‌شود. به این منظور، یک جریان الکتریکی با تغییرات زمانی دلخواه بر روی مقطع برش‌خورده طولی سیم پیچ اعمال شده و شرایط مرزی مناسب نیز بر روی کلیه سطوح خارجی و برش خورده مدل تعریف می‌گردد. پس از حل مسئله، شار مغناطیسی گذرنده از سطح داخلی سیم پیچ در زمان‌های مختلف محاسبه می‌شود. در نهایت نمودار تغییرات شار مغناطیسی در برابر جریان الکتریکی به دست می‌آید. طبق تعریف، شب این نمودار برابر است با ضریب خودالقائی سیم پیچ، لذا با روش حداقل‌سازی مربعات، یک خط راست را با بهترین تقریب از نقاط این نمودار عبور می‌دهیم. به منظور اعتبارسنجی نتایج شبیه‌سازی، شب خط مذکور را که عبارت است از ضریب خودالقائی سیم پیچ، با نتایج تحلیلی مرجع [۹] مقایسه می‌نماییم. پس از تعیین میزان دقت نتایج شبیه‌سازی، همین روش را با در نظر گرفتن قطعه کار در خارج سیم پیچ تکرار می‌کنیم. به این ترتیب ضریب خودالقائی معادل سیم پیچ و قطعه کار

1- Explicit dynamic

2 -Implicit dynamic

3- Meshing

$$I_C R + L \frac{d I_C}{dt} + M \frac{d I_W}{dt} + V_C = 0 \quad (4)$$

لذا در این حالت، جریان I_C به جریان گردابی I_W که در قطعه کار القاء می‌گردد وابسته است و با توجه به توزیع گسترده I_W در قطعه کار، تحلیل مداری فرآیند به سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود.

در مرجع [۱۰] فرض شده است که در فرآیندهای انقباض و انبساط الکترومغناطیسی استوانه، جریان گردابی در تمام طول قطعه کار به طور یکنواخت توزیع شده است و نیز طول سیم پیچ و قطعه کار با هم برابر است. در این شرایط ساده‌سازی شده، روابط زیر برای میدان الکتریکی و شدت میدان مغناطیسی داخل قطعه کار، در حوزه لاپلاس به دست آمده‌اند،

$$\hat{H}_Z = \hat{I}_Z \left[A \frac{I_o(\gamma_r)}{I_o(\gamma_a)} + B \frac{K_o(\gamma_r)}{K_o(\gamma_a)} \right] \quad (5)$$

$$\hat{E}_\varphi = -Z \hat{I}_C \left[A \frac{I_o(\gamma_r)}{I_o(\gamma_a)} - B \frac{K_o(\gamma_r)}{K_o(\gamma_a)} \right] \quad (6)$$

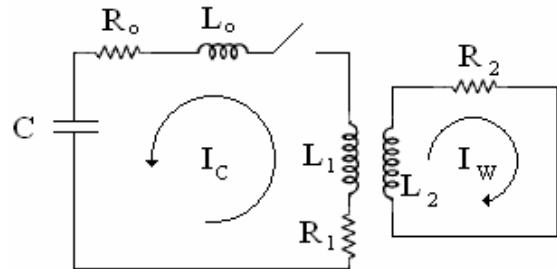
این روابط در دستگاه مختصات استوانه‌ای بیان شده‌اند. ضرایب A و B از شرایط مرزی فرآیندهای انقباض و انبساط استوانه به دست می‌آیند. a شعاع داخلی قطعه کار است و ضرایب Z و γ نیز به صورت زیر تعریف می‌شوند،

$$\gamma = \sqrt{S \sigma \mu}, Z = \sqrt{S \mu / \sigma}$$

فرض‌هایی که برای رسیدن به روابط (۵) و (۶) در نظر گرفته شده‌اند، چندان عملی نیستند. به ویژه در قسمت‌های ابتدا و انتهای طول قطعه کار، اثرات موضعی سبب غیر یکنواخت شدن توزیع جریان گردابی و شدت میدان مغناطیسی می‌گردد. همچنین با توجه به تأثیر فراوان نسبت طول‌های قطعه کار و سیم پیچ در کیفیت توزیع فشار

تحلیل مداری

مدل مداری شماتیک فرآیند شکل دهی الکترومغناطیسی در شکل ۱ نشان داده شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌گردد، در این شکل مقاومت اهمی و خاصیت خودالقائی قطعه کار و مدار دستگاه را به صورت مقاومت و سیم پیچ متمرکز نشان داده‌ایم.



شکل ۱- مدل شماتیک مداری فرآیند شکل دهی

الکترومغناطیسی

در صورتی که قطعه کار وجود نداشته باشد، جریان الکتریکی دستگاه توسط قانون ولتاژ کیرشهف مطابق معادله (۱) به دست می‌آید.

$$I_C R + L \frac{d I_C}{dt} + V_C = 0 \Rightarrow I_C(t) = \frac{V_C}{L \omega_d} e^{-\alpha t} \sin(\omega_d t) \quad (1)$$

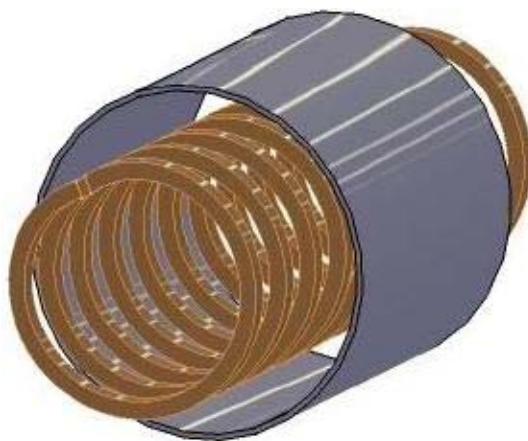
در این رابطه α و ω_d با روابط (۲) و (۳) تعریف می‌شوند.

$$\alpha = \frac{R}{2L}, R = R_o + R_1, L = L_o + L_1 \quad (2)$$

$$\omega_d = \sqrt{\omega_o^2 - \alpha^2}, \omega_o = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (3)$$

اما هنگامی که وجود قطعه کار را در مجاورت سیم پیچ در نظر بگیریم، باید اثر القائی آن را نیز در رفتار مداری دستگاه مد نظر قرار دهیم. در این شرایط، با استفاده از قانون ولتاژ کیرشهف خواهیم داشت،

رفته در مرجع [۵] استفاده می‌کنیم. شکل ۲ تصویر شماتیکی از سیم‌پیچ و قطعه‌کار را در فرآیند انبساط الکترو-مغناطیسی استوانه نشان می‌دهد.



شکل ۲- تصویر شماتیک سیم‌پیچ و قطعه‌کار در فرآیند انبساط الکترو-مغناطیسی استوانه

سیم‌پیچ از جنس مس با $10\ \text{حلقه}$ و قطعه‌کار از جنس آلومنیوم T6-۶۴۶۳ در نظر گرفته شده است. با فرض این‌که فرکانس جریان کتر از $30\ kHz$ باشد، تلفات حاصل از گسیل امواج الکترو-مغناطیسی قابل صرف‌نظر بوده و از تحلیل فرکانس پائین نرم‌افزار استفاده شده است. به دلیل تقارن‌های موجود در مسئله، یک هشتمن از مدل واقعی مسئله شبیه‌سازی شده است. در اطراف سیم‌پیچ و قطعه‌کار، یک حجم کروی از هوا را در نظر می‌گیریم. عمق نفوذ میدان مغناطیسی در سطح داخلی قطعه‌کار با استفاده از رابطه (۷) محاسبه شده است،

$$\delta = \sqrt{\frac{2\rho_e}{\mu_r \mu_0 \omega_d}} \quad (7)$$

بسامد زاویه‌ای (ω_d) را برابر $50000\ Rad/Sec$ در نظر می‌گیریم. در جدول ۱ مشخصات هندسی و خواص مواد ارائه شده است.

مغناطیسی روی قطعه‌کار، در بسیاری از حالت‌های عملی طول‌های این دو نباید با هم برابر باشند.

در مرجع [۱۱] تأثیر عملیات پوشش‌دهی^۱ بر روی عملکرد سیم‌پیچ‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این حالت ضریب خودالقائی سیم‌پیچ با تعریف یک ضریب ثابت، اصلاح شده است. تعریف این ضریب ثابت سه نتیجه زیر را به دست می‌دهد:

۱- وجود محفظه رسانای خارجی سبب کاهش خودالقائی سیم‌پیچ می‌شود.

۲- در این شرایط می‌توان یک ضریب خودالقائی ثابت اصلاح شده را برای سیم‌پیچ در نظر گرفت.

۳- با کاهش نسبت حجم محفظه خارجی به حجم داخلی سیم‌پیچ، ضریب خودالقائی معادل سیم‌پیچ و قطعه‌کار کاهش می‌یابد.

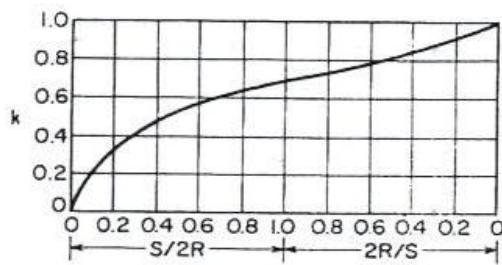
در این مقاله به بررسی این مسئله می‌پردازیم که آیا در فرآیند انبساط الکترو-مغناطیسی استوانه نیز می‌توان ضریب خودالقائی ثابت و اصلاح شده‌ای را برای مجموعه سیم‌پیچ و قطعه‌کار خارجی که آن را احاطه کرده است، به دست آورد. در حقیقت بررسی می‌شود که آیا می‌توان معادله (۱) را با به کار بردن یک ضریب خودالقائی (L) اصلاح شده معادل، به جای معادله (۴) به کار برد. البته توجه به این مسئله لازم است که در این فرآیند، محفظه خارجی کاملاً بسته نیست و از دو انتهای باز می‌باشد.

شبیه‌سازی اجزاء محدود

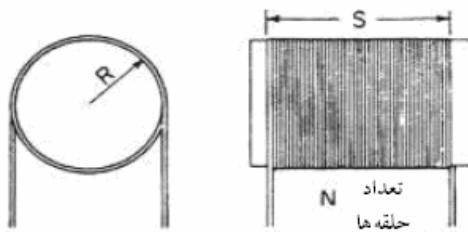
در اینجا برای تعیین ضریب خودالقائی در فرآیند انبساط استوانه، از نرم‌افزار اجزاء محدود ANSYS استفاده می‌کنیم. در این شبیه‌سازی از برخی از فرضیات به کار

ضریب خودالقائی سیم پیچی با طول بی نهایت را به دست می دهد. ضریب k از نمودار شکل ۳، که از یک محاسبه تحلیلی به دست آمده، قابل استخراج است. پارامترهای مربوط به نمودار شکل ۳، در شکل ۴ تعریف شده اند [۹].

$$L = \mu_o \frac{N^2 k A}{L_C} \quad (8)$$



شکل ۳- نمودار ضریب اصلاحی k [۹]



شکل ۴- پارامترهای مربوط به نمودار شکل ۳ [۹]

شکل ۵ مدل اجزاء محدود شبیه سازی سیم پیچ را نشان می دهد.

در شبیه سازی سیم پیچ، جریان الکتریکی به سطحی به ضخامت $3/5\text{ mm}$ از شعاع داخلی سیم پیچ اعمال می گردد. شرایط مرزی اعمال شده بر سطوح مختلف مدل نیز در جدول ۲ ارائه شده است.

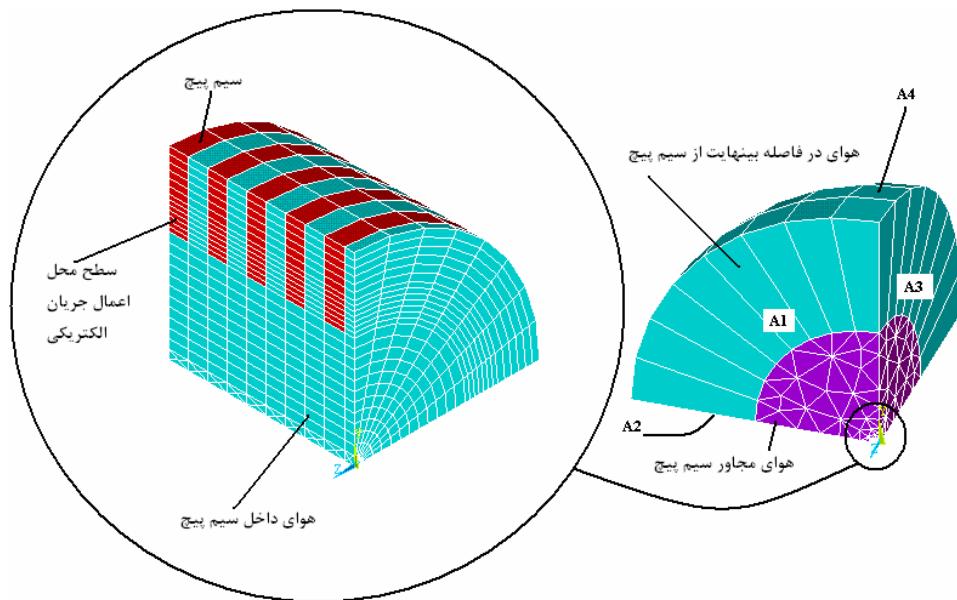
جدول ۱- ابعاد هندسی و خواص مواد

مشخصات سیم پیچ	
مس	جنس
۰/۰۴۰	قطر خارجی (m)
۰/۰۰۸	ضخامت (m)
۰/۰۴	طول (m)
$۱/۶۷ \times 10^{-۸}$	$\rho_e (\Omega m)$
۱	μ_e
مشخصات قطعه کار	
۶۴۶۳-T6	جنس
۰/۰۰۲	ضخامت (m)
۰/۰۳۶	طول (m)
$۳/۱۵ \times 10^{-۸}$	$\rho_e (\Omega m)$
۱	μ_e

برای تعیین یک توزیع جریان مناسب بر روی مقطع برش خورده حلقه های سیم پیچ، ابتدا ضریب خودالقائی یک سیم پیچ استوانه ای را توسط شبیه سازی محاسبه می نماییم سپس همان روش محاسبه ضریب خودالقائی، در مورد مسئله انسپاٹ استوانه به کار می رود.

۱- محاسبه ضریب خودالقائی سیم پیچ های استوانه ای با ابعاد مختلف

ضریب خودالقائی سیم پیچ استوانه ای با فرمول شناخته شده (۸) محاسبه می گردد. در این رابطه k یک ضریب اصلاحی است. در صورتی که $k=1$ باشد، معادله (۸)



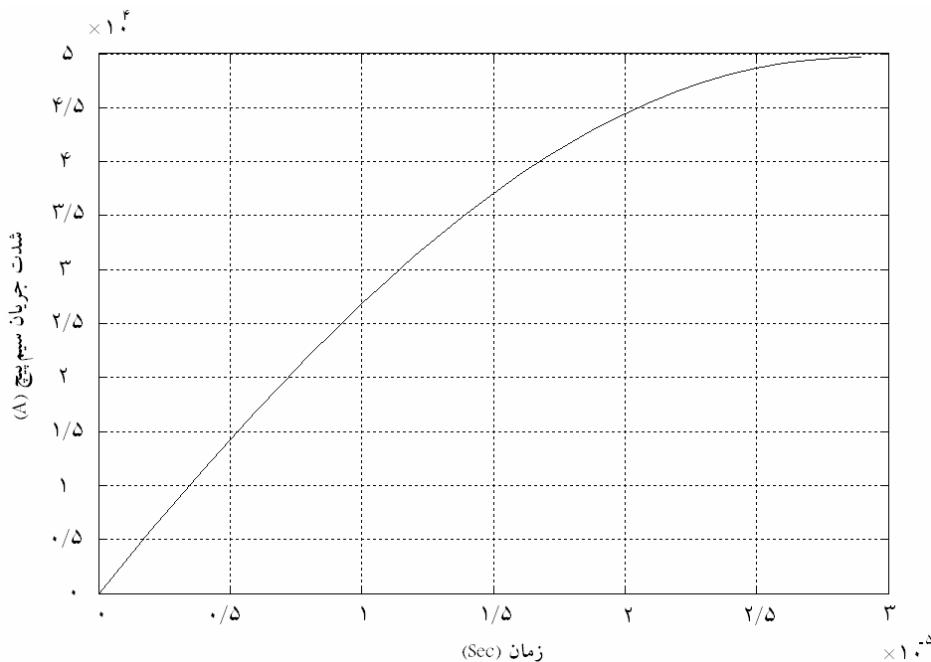
شکل ۵- مدل اجزاء محدود شبیه‌سازی سیم پیچ

جدول ۲- شرایط مرزی در سطوح مختلف مدل اجزاء محدود

اجزاء مدل	سطوح مدل			
	A _۱	A _۲	A _۳	A _۴
مرز بینهایت	$A_X = A_Y = \infty$	$A_X = A_Z = \infty$	$A_X = \infty$	Infinite B.C.
هوای مجاور	$A_X = A_Y = \infty$	$A_X = A_Z = \infty$	$A_X = \infty$	-
سیم پیچ	$A_X = A_Y = \infty$	$A_X = A_Z = Volt = \infty$	$A_X = \infty$	-
قطعه کار	$A_X = A_Y = Volt = \infty$	$A_X = A_Z = Volt = \infty$	$A_X = \infty$	-

اعمال شده است. برای نشان دادن عدم وابستگی نتایج محاسبات از چگونگی تغییرات جریان الکتریکی، فرض می‌کنیم جریان ورودی به سیم پیچ، مطابق نمودار شکل ۶ باشد.

نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهند که در این شرایط، رفتار مغناطیسی سیم پیچ با دقت قابل قبولی بدست می‌آید. در سطوح برش خورده سیم پیچ، شرایط مرزی مناسب مربوط به پتانسیل برداری الکترومغناطیس و پتانسیل الکتریکی



شکل ۶- نمودار تغییرات زمانی جریان الکتریکی سیم پیچ

مقادیر را محاسبه می کنیم. نتیجه برابر با یک چهارم شار مغناطیسی گذرنده از سیم پیچ خواهد بود.

با تکرار این محاسبه برای تمام زمان ها، تغییرات شار مغناطیسی گذرنده از سیم پیچ به ازاء تغییرات جریان الکتریکی به دست می آید. با توجه به تعریف ضریب خودالقائی با رابطه (۹)،

$$L = \frac{d\phi}{dt} \quad (9)$$

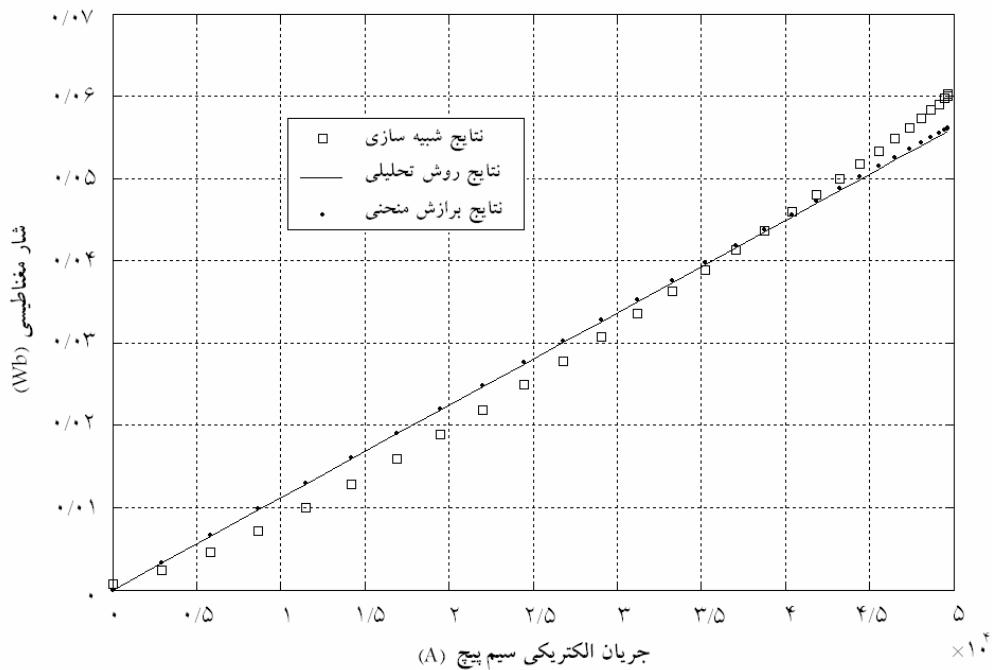
شیب نمودار شار مغناطیسی- جریان الکتریکی، L را نشان می دهد. لذا یک خط راست گذرنده از مبدأ مختصات را با بهترین تقریب از نقاط به دست آمده عبور می دهیم. شیب خط مزبور را با روش حداقل مربعات به دست می آوریم. نتیجه مطابق رابطه (۱۰) خواهد بود.

نمونه ای از چنین نموداری در شکل ۷ نمایش داده شده است.

$$L = \frac{\sum_i \phi_i}{\sum_j I_{Cj}} \quad (10)$$

برای محاسبه ضریب خودالقائی سیم پیچ، جریان الکتریکی شکل ۶ را به آن وارد نموده، و بازه های زمانی حل را برابر $1 \mu Sec$ انتخاب می نمائیم. سپس در هر یک از زمان های حل شده، شار مغناطیسی گذرنده از سیم پیچ را محاسبه می کنیم. همان طور که در شکل ۵ سمت چپ ملاحظه می گردد، گره های مربوط به هوای داخل سیم پیچ در ۱۱ ردیف در راستای طول سیم پیچ قرار گرفته اند.

برای محاسبه شار مغناطیسی گذرنده از سیم پیچ در هر یک از این ردیف ها شار مغناطیسی گذرنده از سطح مقطع تک تک المان ها را محاسبه می کنیم. به این ترتیب که در مورد سطح مقطع هر المان، میانگین مقادیر B چهار گره مربوطه را محاسبه کرده و در مساحت سطح مقطع آن ضرب می کنیم. مجموع همه این مقادیر برابر یک چهارم کل شار مغناطیسی گذرنده از آن مقطع سیم پیچ خواهد بود. همین روند را برای ندهای واقع بر کلیه ردیف های هوای داخل سیم پیچ انجام می دهیم. سپس میانگین این



شکل ۷- نمونه‌ای از نمودار شارمغناطیسی- جریان الکتریکی سیم پیچ

نیز نتایج حل تحلیلی موجود در مرجع [۹] را نشان می‌دهد.

ملحوظه می‌گردد که نتایج حاصل از شبیه‌سازی و معادله (۱۱)، با تقریب خوبی به نمودار شکل ۳ نزدیک است. در شکل ۳، نقطه مربوط به ابعاد سیم‌پیچی که در این مقاله در نظر گرفته شده، با علامت مربع نشان داده شده است. خطای مربوط به این حالت در حدود ۱ درصد می‌باشد. حداقل خطای محاسبه در سایر حالت‌ها نیز در حدود ۷ درصد می‌باشد. محاسبه برای سیم‌پیچ‌هایی با نسبت طول به قطر بین 0.06 تا 0.05 که معمولاً در فرآیند شکل‌دهی الکترومغناطیسی مورد استفاده قرار می‌گیرند انجام شده است. لذا شکل ۸ نشان می‌دهد که مقادیر ضریب خودالقائی محاسبه شده دارای دقت قابل قبولی است. حال همین روش را برای محاسبه ضریب خودالقائی در فرآیند انساط استوانه به کار می‌بریم.

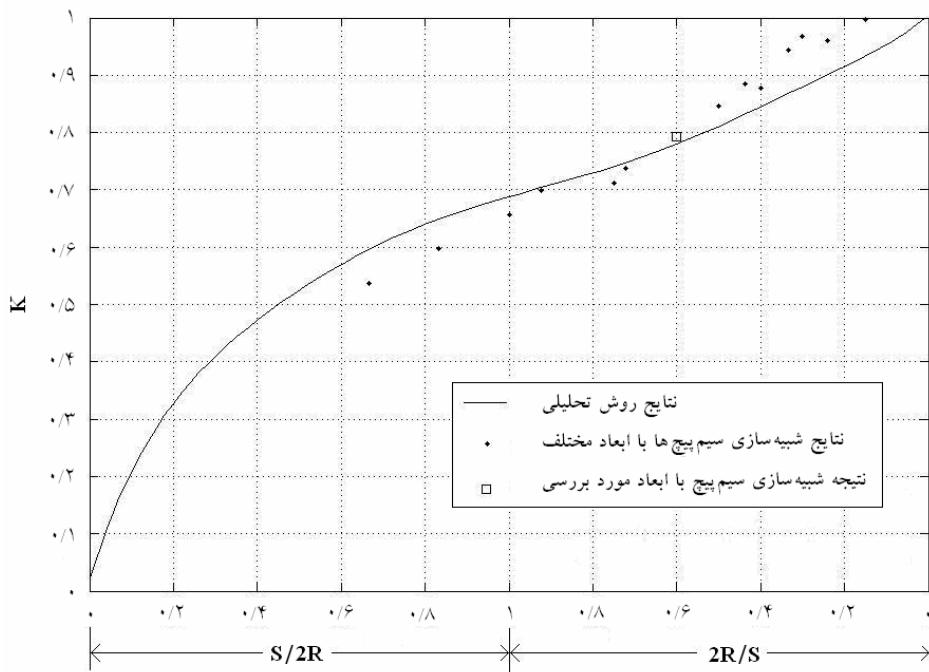
روش فوق را برای سیم‌پیچ‌هایی با نسبت‌های طول به قطر مختلف انجام می‌دهیم. با توجه به معادله (۸) می‌توان نوشت،

$$k = \frac{L}{\mu_0 N^4 A / L_C}$$

اگر در رابطه فوق به جای L ضریب خودالقائی حاصل از شبیه‌سازی را قرار دهیم، معادله (۱۱) حاصل می‌شود.

$$k = \frac{\sum \phi_i / \sum I_{Cj}}{\mu_0 N^4 A / L_C} \quad (11)$$

مقادیر k را برای سیم‌پیچ‌هایی با ابعاد مختلف توسط شبیه‌سازی و معادله (۱۱) بدست آورده‌ایم. نتایج برای مقایسه در شکل ۸ ارائه شده‌اند. در این شکل، نقاط منفصل نتایج شبیه‌سازی را نشان می‌دهند و منحنی پیوسته

شکل ۸- مقایسه مقادیر k حاصل از شبیه‌سازی و نتایج تحلیلی مرجع [۹]

مخالف یکدیگر است. در حقیقت میدان مغناطیسی حاصل از جریان قطعه کار، که جهت آن مخالف میدان مغناطیسی داخل سیم پیچ است، سبب کاهش شار مغناطیسی گذرنده از داخل سیم پیچ و لذا کاهش ضریب خودالقائی آن می شود. مشاهدات تجربی نشان می دهد [۱۲] که چگالی جریان الکتریکی در سطح خارجی یک سیم پیچ بدون وجود پوشش فلزی خارجی، در مقایسه با سطح داخلی آن، بسیار کمتر است. وجود پوشش فلزی در خارج سیم پیچ می تواند سبب افزایش چگالی جریان در سطح خارجی گردد [۱۲]. شکل ۱۰ نیز همین پدیده را نشان می دهد. ملاحظه می گردد که شدت جریان الکتریکی از سطح داخلی به سمت سطح خارجی سیم پیچ به شدت کاهش می یابد. اما در نزدیکی سطح خارجی، اثر القاء مغناطیسی جریان قطعه کار بر روی سیم پیچ، مجدداً سبب افزایش جریان آن می شود. در سطوح برش خورده عمودی و افقی سیم پیچ مقداری خطای عددی وجود دارد که موجب اختشاش موضعی در توزیع چگالی جریان در

۲- محاسبه ضریب خودالقائی معادل در فرآیند انبساط الکترومغناطیسی استوانه

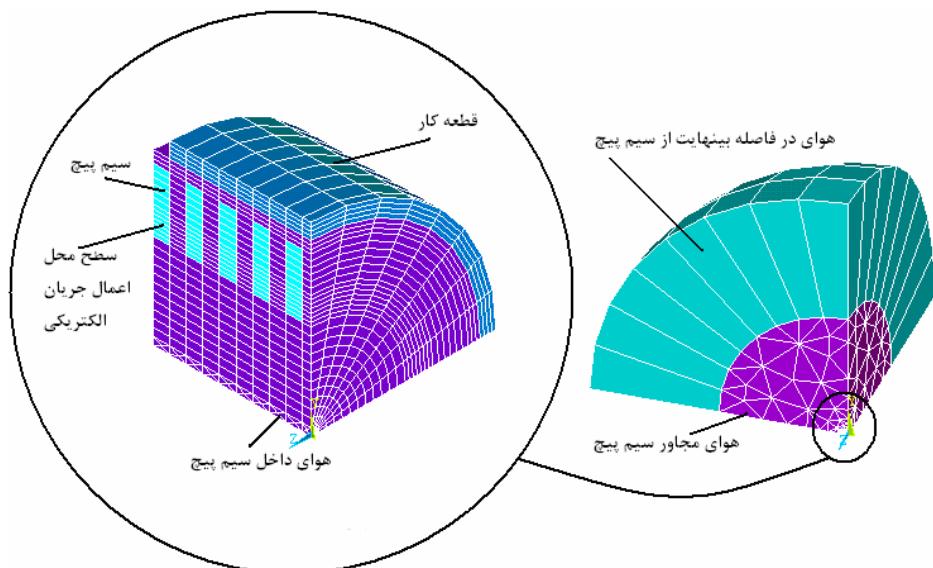
مدل اجزاء محدود فرآیند انبساط الکترومغناطیسی استوانه در شکل ۹ نشان داده شده است. روش بارگذاری و شرایط مرزی کاملاً شبیه مسئله قبل است. در این شبیه سازی به سطوح برش خورده سیم پیچ و قطعه کار، شرایط مرزی مناسب الکتریکی و مغناطیسی اعمال شده است. در این جا نیز با همان روشی که در مورد محاسبه ضریب خودالقائی سیم پیچ توضیح داده شد، با در نظر گرفتن المان های هوای داخل سیم پیچ، که در شکل ۹ سمت چپ مشاهده می گردد و به کار بردن معادله (۱۱)، ضریب خودالقائی را محاسبه می کنیم.

شکل ۱۰ چگالی توزیع جریان الکتریکی در سطح مقطع عرضی قطعه کار و سیم پیچ را در زمان ($5\mu\text{s}$) نشان می دهد. همان طور که انتظار می رود جهت جریان های سیم پیچ و قطعه کار، با توجه به قوانین آمپر و فاراده،

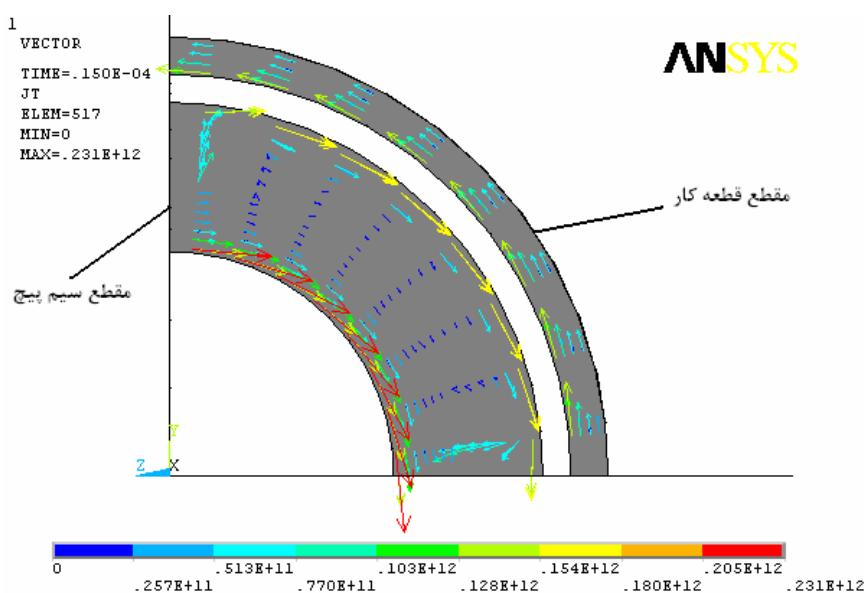
سطح خارجی می‌باشد، که این وضعیت کاملاً طبیعی است.

برای نمونه، نتایج مربوط به قطعه‌کار با قطر داخلی 11 mm در زمان‌های مختلف، در نمودار شکل ۱۱ نمایش داده شده است.

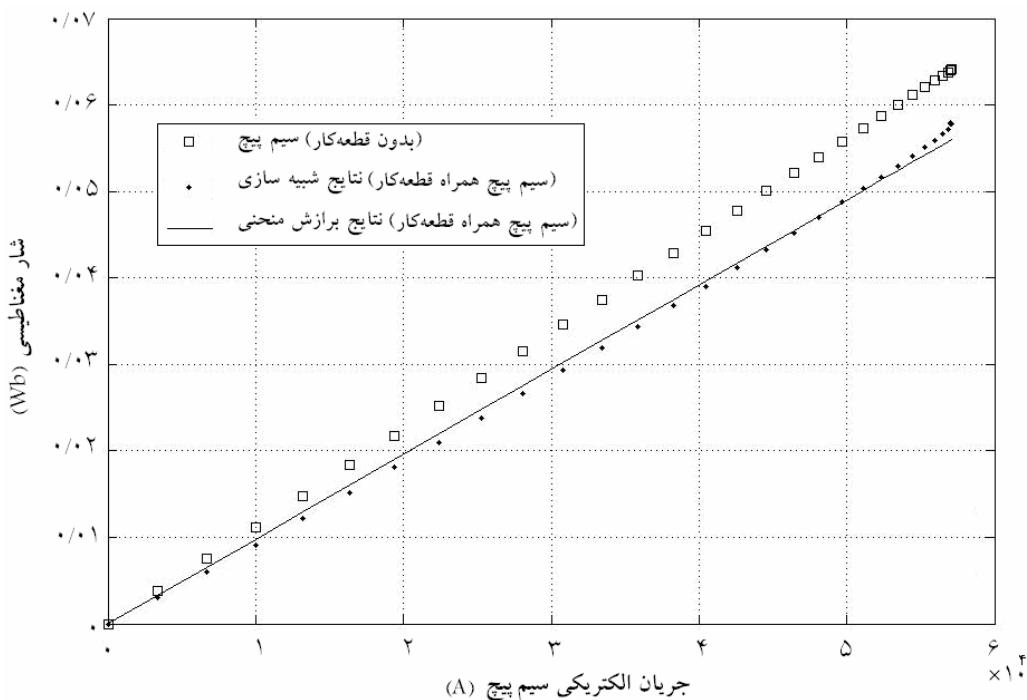
این مقاطع می‌شود. برای به حداقل رساندن اثر این خطای در محاسبات، همان‌طور که قبل‌آن نیز اشاره شد، شار مغناطیسی داخل سیم‌پیچ در ۱۱ مقطع در راستای طول سیم‌پیچ محاسبه و سپس میانگین گرفته شده است. شدت جریان گردابی قطعه‌کار نیز در سطح داخلی آن بیشتر از



شکل ۹- مدل اجزاء محدود شبیه‌سازی فرآیند انبساط استوانه



شکل ۱۰- چگالی توزیع جریان گردابی در قطعه کار در زمان (μs) ۱۵



شکل ۱۱- نمودار شار مغناطیسی - جریان الکتریکی برای قطعه کار با قطر داخلی 0.047 m

جدول ۳- ضرایب خودالقائی معادل برای قطرهای مختلف قطعه کار در فرآیند انساط الکترومغناطیسی استوانه

ضرایب خودالقائی سیم پیچ و قطعه کار	قطر داخلی قطعه کار (m)
5.91×10^{-7}	0.041
6.88×10^{-7}	0.043
8.8388×10^{-7}	0.045
9.8025×10^{-7}	0.047
10.504×10^{-7}	0.049

جدول ۳ نشان می دهد که کاهش قطر و همچنین حجم داخلی قطعه کار سبب کاهش بیشتر ضریب خودالقائی معادل می شود و این رفتار با نتایج تجربی بیان شده در مرجع [۱۱] سازگاری دارد. روابط تجربی موجود در

در شکل ۱۱ مشخصات سیم پیچ مطابق اطلاعات موجود در جدول ۱ می باشد. در این نمودار تغییرات شار مغناطیسی - جریان الکتریکی مربوط به سیم پیچ بدون قطعه کار و سیم پیچ به همراه قطعه کار ارائه شده است. ملاحظه می گردد که قرار گرفتن قطعه کار در مجاورت سیم پیچ موجب کاهش شبیه نمودار شده است. خط راستی که در نمودار رسم شده، با بهترین تقریب از نقاط نمودار مربوط به سیم پیچ و قطعه کار عبور داده شده است. لذا شبیه این خط برابر ضریب خودالقائی معادل سیم پیچ و قطعه کار می باشد.

در اینجا به منظور بررسی تأثیر اندازه قطر قطعه کار در تغییرات ضریب خودالقائی، قطعه کارهایی با قطرهای مختلف مورد بررسی و شبیه سازی قرار گرفته اند و ضریب خودالقائی معادل سیم پیچ و قطعه کار برای آنها محاسبه شده است. جدول ۳ نتایج مربوطه را نشان می دهد.

سیم پیچ ایفا می کند، به وضوح سبب کاهش ضریب خودالقائی سیم پیچ می شود. این پدیده با معادله (۱۲) سازگاری دارد. همچنین نتایج جدول ۳ نیز نشان می دهد که کاهش قطر قطعه کار، که اثری مشابه افزایش نسبت V_C/V_S در معادله (۱۲) دارد، موجب کاهش شدیدتر ضریب خودالقائی سیم پیچ می شود. این رفتار نیز با معادله (۱۲) سازگار است.

لازم به توجه است، همان طور که انتظار می رود، نتایج فوق به دامنه جریان وابسته نیستند. نتایج شبیه سازی ها نشان می دهد که کمتر یا بیشتر کردن دامنه جریان تغییری در نتایج فوق ایجاد نمی کند.

نتیجه گیری

در اعتبارسنجی نتایج در شکل ۸ نشان داده شد که ضریب خودالقائی با روشی که مورد استفاده قرار گرفت، با خطای در حدود ۱ درصد قابل محاسبه است. لذا نتایج جدول ۳ دارای دقت محاسباتی قابل قبولی می باشند. نمودار ۱۱ و نتایج جدول ۳ نشان می دهد که ضریب خودالقائی معادل سیم پیچ، همان طور که انتظار می رود، با قرار گرفتن قطعه کار در خارج آن کاهش پیدا کرده است. داده های جدول ۳ نشان می دهد که ضریب خودالقائی معادل سیم پیچ و قطعه کار، با افزایش قطر قطعه کار نسبت به سیم پیچ افزایش می یابد. این روند نیز با نتایج تجربی مرجع [۱۱] سازگار است.

در کارهای آتی می توان همین بررسی را در مورد فرآیند انقباض الکترو مغناطیسی استوانه انجام داده و رابطه ای مشابه با آن چه در مرجع [۱۰] مطرح شده را برای محاسبه ضریب خودالقائی اصلاح شده در این فرآیندها در نظر گرفت و پارامترهای آن را توسط شبیه سازی برای حالت های مختلف به دست آورد.

مرجع [۱۱] نشان می دهد که چنان چه یک محفظه بسته فلزی، یک سیم پیچ را احاطه کرده باشد، هرچه نسبت حجم محفظه به حجم فضای داخلی سیم پیچ کمتر شود، ضریب خودالقائی معادل سیم پیچ نیز کمتر می شود. رابطه تجربی مربوط به ضریب خودالقائی اصلاح شده سیم پیچ استوانه ای که در مرجع [۱۱] مطرح شده، مطابق معادله (۱۲) می باشد.

$$L = L_0 \left(1 - \frac{2V_C}{3V_S} \frac{a}{K} \right) \quad (12)$$

در معادله (۱۲)، L ضریب خودالقائی سیم پیچ بدون محفظه خارجی، L_0 ضریب خودالقائی اصلاح شده سیم پیچ در اثر وجود محفظه خارجی، V_C حجم فضای داخلی سیم پیچ، V_S حجم محفظه خارجی احاطه کننده سیم پیچ، K یک عدد کوچکتر از ۱ (وقتی طول سیم پیچ با قطر آن برابر باشد، تقریباً $K = 0.7$ خواهد بود [۱۱]) و a یک ضریب وابسته به فرکانس، ابعاد هندسی، نفوذ پذیری مغناطیسی و مقاومت الکتریکی جنس محفظه است. تعیین ضرایب K و a مستلزم انجام تست های تجربی است.

البته به دلیل این که رابطه (۱۲) برای یک محفظه کاملاً بسته ارائه شده است و در اینجا دو انتهای قطعه کار استوانه ای باز می باشد، لذا نتایج عددی این رابطه نمی توان مستقیماً با نتایج این مقاله مقایسه نمود. اما رابطه (۱۲) به وضوح نشان می دهد که L در هر شرایطی کمتر از L_0 است. همچنین، بدیهی است که افزایش نسبت V_C/V_S (که به معنای کوچکتر شدن ابعاد محفظه احاطه کننده سیم پیچ است) سبب کاهش شدیدتر L نسبت به L_0 می شود. همان طور که قبل اشاره شد، نتایج شبیه سازی (شکل ۱۱) نشان می دهد که وجود قطعه کار، که در اینجا نقشی مانند یک محفظه نیمه باز را در اطراف

- [7] Unger, J., Stiemer, M., Svendsen, B. and Blum, H., "Multifield modeling of electromagnetic metal forming processes", *J. Mat. Proc. Tech.*, Elsevier, 177 (2006) 270–273.
- [8] Wang, L., Chen, Z.Y., Li, C.X. and Huang, S.Y., "Numerical simulation of the electromagnetic sheet metal bulging process", *Int. J. Adv. Manuf. Tech.*, Springer-Verlag, 30 (2006) 395–400.
- [9] Boast, W.B., "Vector Fields", 2nd Ed., Harper & Row Pub., New York (1964).
- [10] Motoasca, T.E., "Electrodynamics in Deformable Solids for Electromagnetic Forming", PhD Thesis, Department of Electrical Engineering, Delft University, Netherlands, (2003).
- [11] Pender, H., "Electrical Engineering's Handbook", 4th Ed., Knox Mcilwain, John Wiley & Sons, New York (1950).
- [12] Göbl , N., "Unified calculating method of equivalent circuits of the electromagnetic forming tools", Ph.D. Thesis, Technical University of Budapest, (1978).

مراجع

- [1] Murakoshi, Y., Takahashi, M., Sano, T., Hanada, K. and Negishi, H., "Inside bead forming of aluminium tube by electromagnetic forming", *J. Mat. Proc. Tech.*, ELSEVIER, 80-81 (1998) 695-699.
- [2] Fenton, G.K. and Daehn, G.S., "Modeling of electromagnetically formed sheet metal", *J. Mat. Proc. Tech.*, ELSEVIER, 75 (1998) 6-16.
- [3] Chunfeng, L., Zhiheng, Z., Jianhui, L., Yongzhi, W. and Yuying, Y., "Numerical simulation of magnetic pressure in tube electromagnetic bulging", *J. Mat. Proc. Tech.*, ELSEVIER, 123 (2002) 225-228.
- [4] El-Azab, A., Garnich, M. and Kapoor, A., "Modeling of the electromagnetic forming of sheet metals: state-of-the-art and future needs", *J. Mat. Proc. Tech.*, Elsevier, 142 (2003) 744–754.
- [5] Mamalis, A.G., Manolakos, D.E., Kladas, A.G. and Koumoutsos, A.K., "Physical principles of electromagnetic forming process: a costitutive finite element model", *J. Mat. Proc. Tech.*, ELSEVIER, 161 (2005) 294-299.
- [6] Oliveira, D.A., Worswick, M.J., Finn, M. and Newman, D., "Electromagnetic forming of aluminium alloy sheet: Free-form and cavity fill experiments and model", *J. Mat. Proc. Tech.*, Article in press, ELSEVIER, (2005).